(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2004年7月22日(22.07.2004)

**PCT** 

(10) 国際公開番号 WO 2004/061885 A1

(51) 国際特許分類7: H01H 37/76, 85/046, 85/08, 85/12

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/015603

(22) 国際出願日:

2003年12月5日(05.12.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2002-382566

2002年12月27日(27.12.2002)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ソニーケ ミカル株式会社 (SONY CHEMICALS CORP.) [JP/JP]; 〒141-0032 東京都 品川区 大崎一丁目11番2号 ゲー トシティ大崎イーストタワー8階 Tokyo (JP).

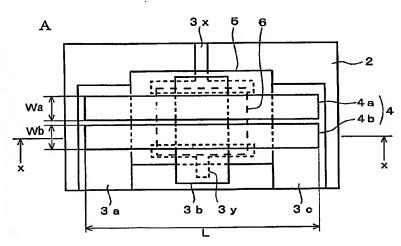
(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 古内 裕治(FU-RUUCHI, Yuji) [JP/JP]; 〒322-8502 栃木県 鹿沼市 さつ き町 1 2-3 ソニーケミカル株式会社内 Tochigi (JP). 田村 久弥 (TAMURA, Hisaya) [JP/JP]; 〒322-8502 栃木 県 鹿沼市 さつき町 1 2-3 ソニーケミカル株式会 社内 Tochigi (JP). 松吉 雅弘 (MATSUYOSHI, Masahiro) [JP/JP]; 〒322-8502 栃木県 鹿沼市 さつき町 1 2-3 ソ ニーケミカル株式会社内 Tochigi (JP). 古田 和隆 (FU-RUTA, Kazutaka) [JP/JP]; 〒322-8502 栃木県 鹿沼市

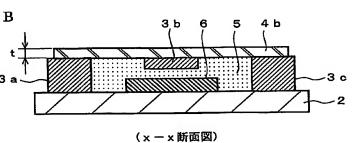
[続葉有]

(54) Title: PROTECTION ELEMENT

(54) 発明の名称: 保護素子



1 A



(x-x SECTION DIAGRAM)

(57) Abstract: A protection element, comprising a heating low-meltelement and the ing-point metal element that are formed on a substrate, the low-melting-point metal element being fused by heating of the heating element, wherein the section of at least part of the low-melting-point metal element is segmented into substantially at least two independent sections by providing at least two strips of low-melting-point metal element between a pair of electrodes that feed a current to the low-melting-point metal element. This protection element is shortened and stabilized in operating time. In addition, at least two strips of low-melting-point metal element are preferably provided between the pair of electrodes that feed a current to the low-melting-point metal element. It is also preferable to provide one strip of low-melting-point metal element slit at the center thereof between the pair of electrodes that feed a current to the low-melting-point metal element.

(57) 要約: 基板上に発熱体及

び低融点金属体を有し、発熱体の発熱により低融点金属体が溶断する保護素子は、低融点金属体に電流を通す一対 の電極間において、

## WO 2004/061885 A1

さつき町 1 2-3 ソニーケミカル株式会社内 Tochigi (JP). 川津 雅巳 (KAWAZU,Masami) [JP/JP]; 〒322-8502 栃木県 鹿沼市 さつき町 1 2-3 ソニーケミカル株式 会社内 Tochigi (JP).

(74) 代理人: 田治米 登, 外(TAJIME,Noboru et al.); 〒 214-0034 神奈川県 川崎市 多摩区三田 1-2 6-2 8 ニューウェル生田ビル 2 O 1 号室 Kanagawa (JP).

(81) 指定国(国内): CN, KR, US.

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

#### 明 細 書

## 保護素子

#### 5 技術分野

本発明は、異常時に発熱体が発熱し、低融点金属体が溶断する保護素子に関する。

## 背景技術

20

10 過電流だけでなく過電圧も防止することができ、携帯用電子機器の二次電池等に有用な保護素子として、基板上に発熱体と低融点金属体を積層あるいは平面配置した保護素子が知られている(日本国特許第2790433号、特開平10-116549号公報)。このタイプの保護素子では、異常時に、発熱体に通電がなされ、発熱体が発熱することにより低融点金属が溶断する。

近年、携帯用電子機器の高性能化に伴い、上述の保護素子に対しては、 定格電流を高めることが求められている。保護素子の定格電流を高める ためには、低融点金属体の厚み又は幅を大きくすることによりその断面 積を大きくして抵抗を低くすることが考えられる。しかしながら、低融 点金属体の断面積を大きくすると、過電流又は過電圧時に電流が遮断さ れるのに要する動作時間が長くなるという問題が生じる。また、低融点 金属体の厚みを厚くすることは、素子の薄型化の要請にも反する。

さらに、上述の保護素子には、発熱体の発熱により低融点金属体が溶融状態になってから溶断するまでの時間が安定しないという問題があり、 25 低融点金属体と溶断有効電極面積とに所定の関係を持たせることなどが 提案されている(特開2001-325869号公報)。 本発明は、基板上に発熱体及び低融点金属体を有し、発熱体の発熱により低融点金属体が溶断する保護素子において、定格電流を高くするために、低融点金属体の断面積を大きくした場合においても動作時間を短くし、かつ発熱体の発熱から溶断までの時間を安定化させることを目的とする。

## 発明の開示

5

10

15

本発明者は、低融点金属体に電流を通す一対の電極間に、2条以上の低融点金属体を設けるなどにより、その電極間の低融点金属体の横断面を2以上の独立的な断面に区分すると、低融点金属体における溶断開始点が増え、動作時間が短縮し、かつ動作時間が安定することを見出した。即ち、本発明は、基板上に発熱体及び低融点金属体を有し、発熱体の発熱により低融点金属体が溶断する保護素子であって、低融点金属体に電流を通す一対の電極間において、低融点金属体の少なくとも一部の横断面が、実質的に2以上の独立的な断面に区分されていることを特徴とする保護素子を提供する。

ここで、低融点金属体の横断面とは、該低融点金属体を流れる電流の 方向と垂直な低融点金属体の断面をいう。

また、低融点金属体の横断面が、実質的に、2以上の独立的な断面に 20 区分されているとは、低融点金属体の横断面が、発熱体の発熱前に2以上の独立的な断面に区分されている場合だけでなく、発熱体の発熱前は 一つの連続域の断面だが、発熱体の発熱により速やかに2以上の独立的 な断面に区分される形状になっている場合をいう。

#### 25 図面の簡単な説明

第1図Aは、本発明の保護素子の平面図であり、第1図Bは、その断

面図である。

- 第2図は、本発明の保護素子の溶断開始時の平面図である。
- 第3図A~Eは、本発明の保護素子の製造工程図である。
- 第4図は、本発明の保護素子を用いた過電圧防止装置の回路図である。
- 5 第5図は、本発明の保護素子の平面図である。
  - 第6図は、本発明の保護素子の溶断開始時の平面図である。
  - 第7図は、本発明の保護素子の平面図である。
  - 第8図は、本発明の保護素子の平面図である。
  - 第9図は、本発明の保護素子の溶断開始時の平面図である。
- 10 第10図Aは、本発明の保護素子の平面図であり、第10図B及び第 10図Cはその断面図である。
  - 第11図は、本発明の保護素子の溶断開始時の断面図である。
  - 第12図Aは、本発明の保護素子の平面図であり、第12図Bはその 断面図である。
- 15 第13図は、本発明の保護素子を用いた過電圧防止装置の回路図である。
  - 第14.図Aは、従来の保護素子の平面図であり、第14図Bは、その 断面図である。
    - 第15図は、従来の保護素子の溶断開始時の平面図である。

20

発明を実施するための最良の形態

以下、図面を参照しつつ、本発明を詳細に説明する。なお、各図中、 同一符号は同一又は同等の構成要素を表している。

第1図Aは、本発明の一態様の保護素子1Aの平面図であり、第1図 25 Bはその断面図である。この保護素子1Aは、基板2上に発熱体6、絶 縁層5及び低融点金属体4が順次積層された構造を有している。ここで、

低融点金属体 4 は、幅Wa、厚さt、長さLの第1の平板状低融点金属体 4 a と、この平板状低融点金属体 4 a と同じ幅Wb、厚さt、長さLの第2の平板状低融点金属体 4 b の 2 条からなり、それぞれ両端が電極 3 a、3 c に接続し、中央部が電極 3 b に接続している。

5 このように低融点金属体 4 として 2 条の平板状低融点金属体 4 a、 4 b を水平に並置すると、発熱帯 6 が発熱した場合に、 2 条の平板状低融点金属体 4 a、 4 b がそれぞれ溶融し、まず、第 2 図に示すように、電極 3 a と電極 3 b の間、及び電極 3 b と電極 3 c の間にある、平板状低融点金属体 4 a、 4 b の両側辺の中央部(合計 8 箇所)が溶断開始点 P 2 となり、この溶断開始点 P から矢印のように平板状低融点金属体 4 a、 4 b がくびれ始める。次いで、表面張力により、低融点金属体は、電極 3 a、 3 b あるいは 3 c 上で球状になろうとし、溶断開始点 P のくびれが大きくなって 4 箇所で溶断する。

これに対して、第15図の保護素子1Xのように、低融点金属体として、厚さ t と長さLが上述の平板状低融点金属体 4 a、 4 b と同じで、幅Wが平板状低融点金属体 4 a、 4 b の幅Wa、 Wb の合計に等しい(即ち、横断面の断面積が、低融点金属体 4 a、 4 b の横断面の断面積の合計に等しく、定格電流(ヒューズ抵抗値)が、第1図Aの保護素子1Aと同じとなる)1条の低融点金属体 4 を設けると、この低融点金属体 4 な を設けると、この低融点金属体 4 な を設けると、この低融点金の発熱時により、第15図に矢印で示すように 4 箇所の溶断開始点 P からくびれ始め、溶断する。

したがって、第1図Aの保護素子1Aのように、低融点金属体4の横断面を、第1の平板状低融点金属体4aによる横断面と第2の平板状低融点金属体4bによる横断面の2つの区域に区分することにより、溶断開始点Pが増え、また、溶融した低融点金属体4が、電極3a、3bあるいは3c上に流れ込み易くなるので、動作時間が短縮する。

15

20

さらに、一般に、低融点金属体 4 の下地となっている絶縁層 5 の表面 状態等によって低融点金属体の溶断時間は変動するところ、第 1 図 A の 保護素子 1 A のように、電極 3 a と電極 3 b、あるいは電極 3 b と電極 3 c という一対の電極間に 2 条の平板状低融点金属体 4 a、 4 b を設け ると、一対の電極体間において 2 条の内の一方の平板状低融点金属体が 溶断したときに、残りの平板状低融点金属体には、一方の平板状低融点 金属体が溶断する前の電流の倍の電流が流れるので、残りの平板状低融 点金属体も速やかに溶断する。したがって、保護素子 1 A の動作時間の バラツキが低減する。

10 また、溶断後に電極3a、3b又は3c上に集まる低融点金属体4の 厚みは、第1図Aの保護素子1Aの方が第15図の保護素子1Xよりも 薄くなる。したがって、一対の電極間の低融点金属体を2条とした第1 図Aの保護素子1Aの方が、素子の薄型化を押し進めることが可能とな る。

第1図Aの保護素子1Aは、例えば、第3図A~第3図Eに示すように製造することができる。まず、基板2上に発熱体6用の電極(所謂、枕電極)3x、3yを形成し(第3図A)、次いで、発熱体6を形成する(第3図B)。この発熱体6は、例えば、酸化ルテニウム系ペーストを印刷し、焼成することにより形成する。次に、必要に応じて、発熱体6の抵抗値の調節のため、エキシマレーザー等で発熱体6にトリーミングを形成した後、発熱体6を覆うように絶縁層5を形成する(第3図C)。次に、低融点金属体用の電極3a、3b、3cを形成する(第3図D)。そして、この電極3a、3b、3cに橋かけするように2条の平板状低融点金属体4a、4bを設ける(第3図E)。

25 ここで、基板 2 、電極 3 a 、 3 b 、 3 c 、 3 x 、 3 y 、発熱体 6 、 絶 縁層 5 、低融点金属体 4 の形成素材やそれ自体の形成方法は従来例と同

15

20

25

様とすることができる。したがって、例えば、基板2としては、プラス チックフィルム、ガラスエポキシ基板、セラミック基板、金属基板等を 使用することができ、好ましくは、無機系基板を使用する。

発熱体6は、例えば、酸化ルテニウム、カーボンブラック等の導電材料と水ガラス等の無機系バインダあるいは熱硬化性樹脂等の有機系バインダからなる抵抗ペーストを塗布し、必要に応じて焼成することにより形成できる。また、発熱体6は、酸化ルテニウム、カーボンブラック等の薄膜を印刷、メッキ、蒸着、スパッタ等により形成してもよく、これらのフィルムの貼付、積層等により形成してもよい。

10 低融点金属体4の形成材料としては、従来よりヒューズ材料として使用されている種々の低融点金属体を使用することができ、例えば、特開平8-161990号公報の段落[0019]の表1に記載の合金を使用することができる。

低融点金属体用の電極3a、3b、3cとしては、銅等の金属単体、 あるいは表面がAg-Pt、Au等でメッキされている電極を使用する ことができる。

第1図Aの保護素子1Aの使用方法としては、例えば、第4図に示すように、過電圧防止装置で用いられる。第4図の過電圧防止装置おいて、端子A1、A2には、例えばリチウムイオン電池等の被保護装置の電極端子が接続され、端子B1、B2には、被保護装置に接続して使用される充電器等の装置の電極端子が接続される。この過電圧防止装置によれば、リチウムイオン電池の充電が進行し、ツエナダイオードDに降伏電圧以上の逆電圧が印加されると、急激にベース電流ibが流れ、それにより大きなコレクタ電流icが発熱体6に流れ、発熱体6が発熱する。この熱が、発熱体6上の低融点金属体4に伝達し、低融点金属体4が溶断し、端子A1、A2に過電圧の印加されることが防止される。またこの場合、

10

15

20

低融点金属体4は電極3aと電極3bの間、及び電極3bと電極3cの間でそれぞれ溶断されるので、溶断後には、発熱体6への通電が完全に遮断される。

本発明の保護素子は種々の態様をとることができる。保護素子の動作特性上は、2条の低融点金属体4a、4bの間隔は広い方がよいが、第5図に示す保護素子1Bのように、2条の平板状低融点金属体4a、4bを接触させて配設してもよい。このように2条の平板状低融点金属体4a、4bを接触させても、発熱体6の発熱時には、第6図に示すように、8カ所の溶断開始点Pから溶断が始まるので、動作時間を短縮し、動作時間のバラツキを低減させ、素子の薄型化を図ることができる。

第7図の保護素子1Cは、第1図Aの2条の平板状低融点金属体4a、4bに代えて、4条の平板状低融点金属体4c、4d、4e、4fを、それらの合計の横断面積が、第1図Aの2条の平板状低融点金属体4a、4bの合計の横断面積と等しくなるように設けたものである。

このように、低融点金属体4の横断面の区分数を増やすことにより、より一層動作時間を短縮し、また動作時間のバラツキを抑制することができる。本発明において、低融点金属体の横断面の区分数には、特に制限はない。

第8図の保護素子1Dは、電極3aと電極3bとの間、及び電極3b と電極3cとの間において、低融点金属体4に、その横断面が2つに区 分された領域ができるように、これらの電極間に、電流の流れる方向に 伸びたスリット7を設けたものである。

このようにスリット7を形成することによっても、発熱体6の発熱時により、低融点金属体4は、第9図に示すように8カ所の溶断開始点P25 から矢印のようにくびれ始めるので、動作時間を短縮し、動作時間のバラツキを低減させ、素子の薄型化を図ることができる。

なお、スリットにより低融点金属体の横断面を独立的な区域に区分する場合にも、その区分数には、特に制限はない。

第10図Aの保護素子1Eは、発熱体6の発熱前においては、低融点 金属体4の横断面が、1つの連続域からなるが、電流の流れる方向に伸 びた溝8が低融点金属体4の中央部に設けられ、その部分の低融点金属 体4が肉薄になることにより、発熱体6の発熱時には、速やかに、第1 1図に示したように、2つの独立的な断面に区分されるようにしたもの である。2つの独立的な断面に区分された後は、第1図Aの保護素子と 同様に作用する。

10 本発明の保護素子は、低融点金属体が、電極3aと電極3b、及び電極3bと電極3bという二対の電極間でそれぞれ溶断するものに限らず、その用途に応じて、一対の電極間でのみ溶断するように構成してもよい。例えば、第13図に示した回路図の過電圧防止装置で用いる保護素子は、第12図Aに示す保護素子1Fのように、電極3bを省略した構成とすることができる。この保護素子1Fにおいても、一対の電極間3a、3cに、2条の平板状低融点金属体4a、4bが設けられている。

この他、本発明の保護素子において、個々の低融点金属体4の形状は 平板状に限らない。例えば、丸棒状としてもよい。また、低融点金属体 4は、絶縁層5を介して発熱体6上に積層する場合に限らない。低融点 金属体と発熱体とを平面配置し、発熱体の発熱により低融点金属体が溶 断するようにしてもよい。

また、本発明の保護素子において、低融点金属体上は、4,6-ナイロン、液晶ポリマー等を用いてキャッピングすることができる。

### 25 実施例

20

以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明する。

## 実施例1

5

第1図Aの保護素子1Aを次のようにして作製した。基板2として、アルミナ系セラミック基板(厚さ0.5 mm、大きさ5 mm×3 mm)を用意し、これに銀ーパラジウムペースト(デュポン社製、6177T)を印刷し、焼成(850℃、0.5時間)することにより発熱体6用の電極3x、3yを形成した。

次に、酸化ルテニウム系ペースト (デュポン社製、DP1900) を印刷し、 焼成 (850℃、0.5時間) することにより発熱体 6を形成した。

その後、発熱体 6 上に絶縁ガラスペーストを印刷することにより絶縁 10 層 5 を形成し、さらに、低融点金属体用の電極 3 a 、 3 b 、 3 c を 、銀 一白金ペースト (デュポン社製、5164N) を印刷し、焼成 (8 5 0 ℃、0. 5 時間) することにより形成した。この電極 3 a 、 3 b 、 3 c に橋かけ するように、低融点金属体 4 として半田箔 (Sn:Sb=95:5、液 相点 2 4 0 ℃、幅W=0.5 mm、厚さ t=0.1 mm、長さL=4.

15 0 mm)を2本接続し、保護素子1Aを得た。

## 実施例2

低融点金属体 4 として、幅W=0. 5 mmの半田箔 2 本に代えて、幅W=0. 2 5 mmの半田箔を 4 本使用する以外は、実施例 1 と同様にして保護素子 1 C (第 7 図)を作製した。

#### 20 比較例1

低融点金属体 4 として、幅W=0. 5 m m の半田箔 2 本に代えて、幅W=1 m m の半田箔を 1 本使用する以外は、実施例 1 と同様にして保護素子 1 X (第 1 4 Y0) を作製した。

#### 実施例3

25 低融点金属体の厚さ t を 0.3 mmとする以外は実施例 1 と同様にして保護素子 1 A を作製した。

### 実施例4

低融点金属体の厚さ t を 0.3 mmとする以外は実施例 2 と同様にして保護素子 1 A を作製した。

### 比較例2

5 低融点金属体の厚さ t を 0.3 m m とする以外は比較例 1 と同様にして保護素子 1 X を作製した。

### 評価

実施例1~4及び比較例1、2の各保護素子の発熱体に4Wの電力を 印加し、その電力を印加してから低融点金属体が溶断するまでの時間 (ヒューズ溶断時間)を測定した。

また、実施例3、4及び比較例2の保護素子に対しては、低融点金属体に12Aの電流を通し、通電後低融点金属体が溶断するまでの時間を測定した。結果を表1に示す。

表 1

15

10

	低融点金属体				溶断時間(秒)		
	大きさ(単位: mm)			抵抗	<u>本数</u>	発熱体	低融点金属体
	幅双	厚さt	長さL	(mΩ)	(本)	4♥印加時	12A通電時
実施例1	0.5	0.1	4.0	10±1	2	12~16	
実施例2	0. 25	0.1	4.0	10±1	4	10~13	
比較例1	1.0	0.1	4.0	10±1	1	15~25	
実施例3	0.5	0.3	4.0	5±1	2	20~30	9~12
実施例4	0. 25	0.3	4. 0	5±1	4	15~18	8~11
比較例 2	1.0	0.3	4.0	5±1	1	120秒で溶断も	ታ <b>ቻ</b> 10∼16

この結果から、本発明の実施例によれば、定格電流(ヒューズ抵抗

11

値)を変えることなく、発熱体が発熱したときの動作時間を短縮し、か つ動作時間のバラツキを抑制できることがわかる。また、低融点金属体 に過電流が流れた場合の動作時間も短縮し、そのバラツキを抑制できる ことがわかる。

5

#### 産業上の利用分野

本発明によれば、基板上に発熱体及び低融点金属体を有し、発熱体の 発熱により低融点金属体が溶断する保護素子において、動作時間を短縮 し、かつ安定化させることができる。したがって、定格電流を高くする 10 ために、低融点金属体の断面積を大きくしても、動作時間を十分に短く し、かつ動作時間のバラツキを抑制することができる。

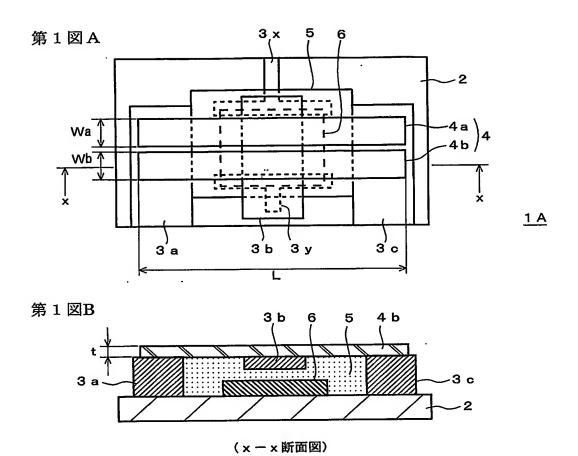
## 請 求 の 範 囲

- 1. 基板上に発熱体及び低融点金属体を有し、発熱体の発熱により 低融点金属体が溶断する保護素子であって、低融点金属体に電流を通す 一対の電極間において、低融点金属体の少なくとも一部の横断面が、実 質的に2以上の独立的な断面に区分されていることを特徴とする保護素 子。
- 2. 低融点金属体に電流を通す一対の電極間に、2条以上の低融 10 点金属体が設けられている請求の範囲第1項記載の保護素子。
  - 3. 低融点金属体に電流を通す一対の電極間に、中央部にスリットの入った1条の低融点金属体が設けられている請求の範囲第1項記載の保護素子。

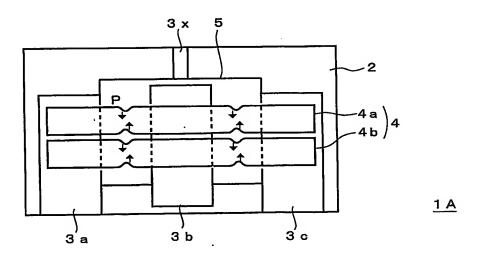
15

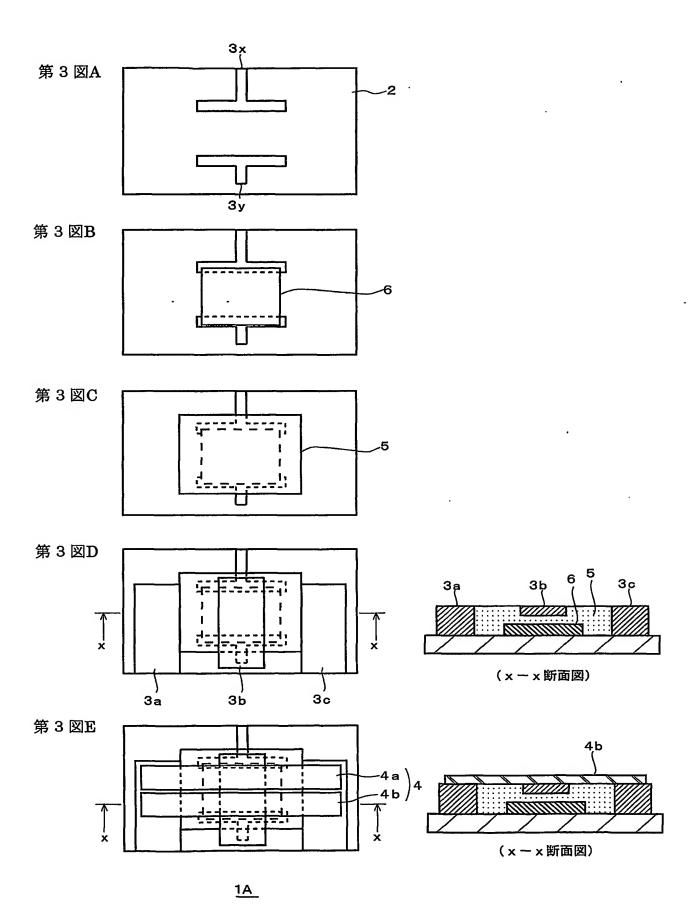
5

4. 低融点金属体に電流を通す一対の電極間において、低融点金属体に、該低融点金属体の少なくとも一部の横断面が発熱体の発熱時に 2以上の独立的な断面に区分されるように、肉薄部が形成されている請求の範囲第1項記載の保護素子。

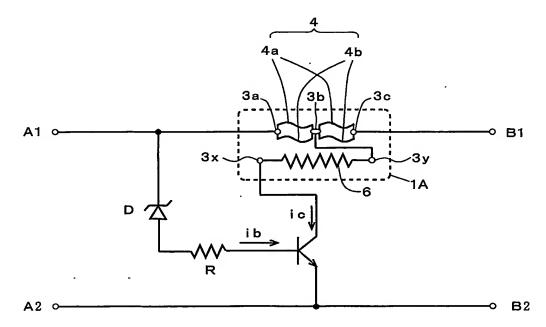


第2図

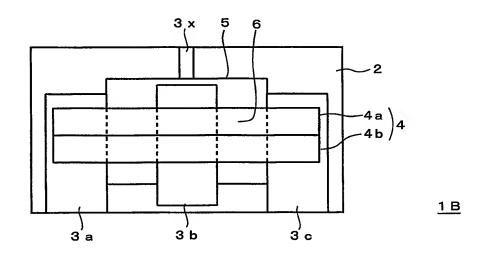




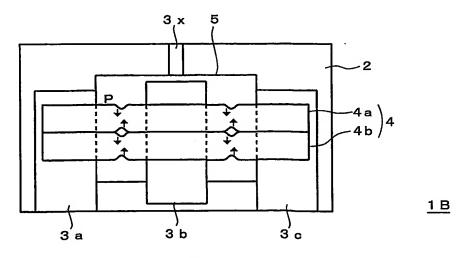
第4図



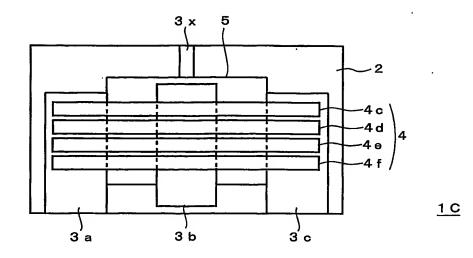
第5図



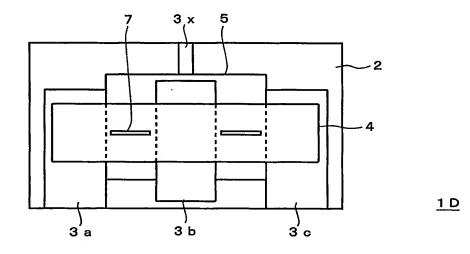
第6図



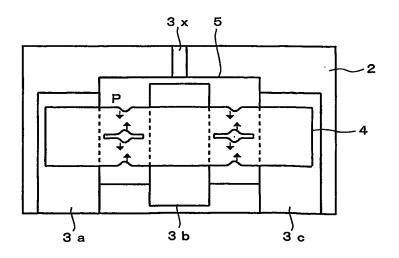
第7図



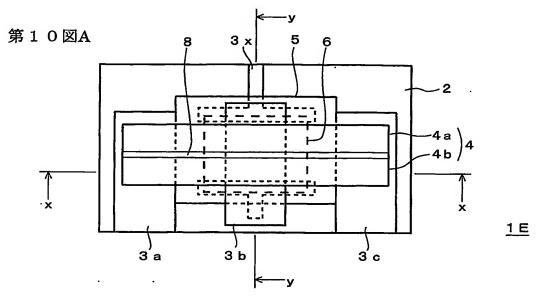
第8図

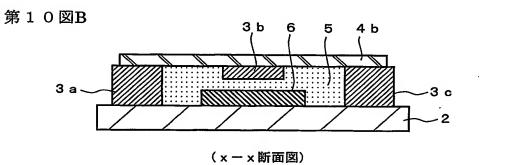


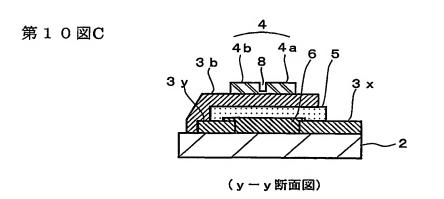
第9図

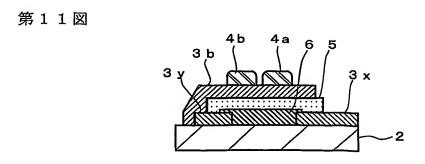


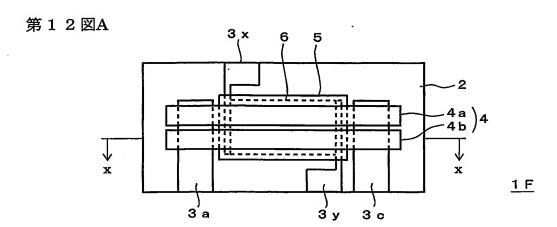
<u>1 D</u>

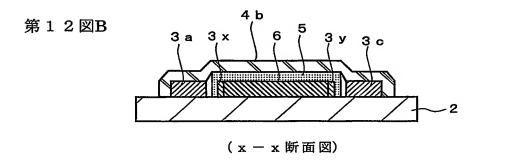


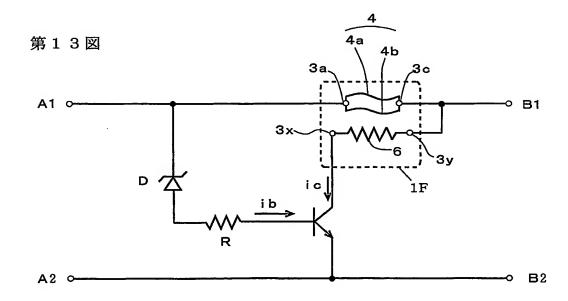


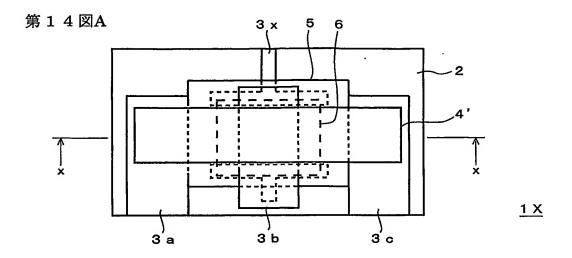


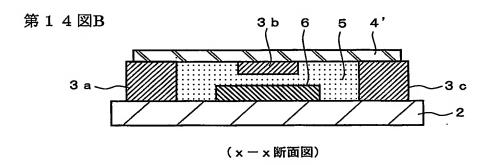




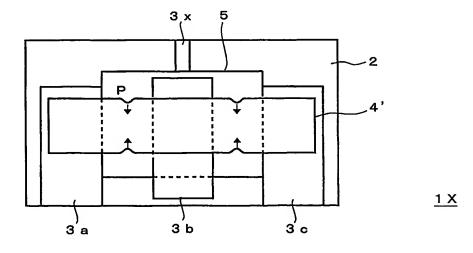








第15図



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/15603

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> H01H37/76, 85/046, 85/08, 85/12					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	SEARCHED		•		
Minimum do	cumentation searched (classification system followed b	y classification symbols)			
Int.	Int.Cl <sup>7</sup> H01H37/76, 85/00-85/62				
Documentati	on searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched		
Jitsu	yo Shinan Koho 1926—1996 Jitsuyo Shinan Koho 1971—2004	Toroku Jitsuyo Shinan Koko Jitsuyo Shinan Toroku Koko	o 1994–2004		
Electronic da	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	ch terms used)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	JP 2001-325868 A (Sony Chemic		1-3 4		
A	22 November, 2001 (22.11.01), Full text; Figs. 1 to 9		· ·		
	& US 2001-44168 A				
Y	JP 2000-306477 A (Sony Chemic	cals Corp.).	1-3		
A	02 November, 2000 (02.11.00),		4		
	Full text; Figs. 1 to 7	6452475 B			
	& EP 1045418 A & US	UIJATIJ D			
Y	JP 2000-285778 A (Sony Chemi	cals Corp.),	1-3 4		
A	13 October, 2000 (13.10.00), Full text; Figs. 1 to 13	•	4		
.	& EP 1041597 A & US	6344633 B			
	·				
	•				
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to</li> </ul>					
considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot l					
date considered novel or cannot be considered to involve an inven			ered to involve an inventive		
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention canno					
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such					
means combination being obvious to a person skilled in the art "P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed					
Date of the actual completion of the international search 10 March, 2004 (10.03.04)  Date of mailing of the international search report 30 March, 2004 (30.03.04)					
Name and mailing address of the ISA/  Authorized officer					
Japa	Japanese Patent Office				
Facsimile No.		Telephone No.			

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/15603

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 11-7846 A (Uchihashi Esutekku Kabushiki Kaisha), 12 January, 1999 (12.01.99), Claim 1; Fig. 1 (Family: none)	1-3
Y	JP 52-31363 A (McGraw-Edison Co.), 09 March, 1977 (09.03.77), Full text; Figs. 1 to 46 & DE 2543889 A & FR 2287102 A & US 4041435 A	1,3
Y	JP 53-8755 A (McGraw-Edison Co.), 26 January, 1978 (26.01.78), Full text; Figs. 1 to 9 & DE 2723487 A & FR 2352389 A & US 4101860 A	1,3
A	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 200537/1985(Laid-open No. 107335/1987) (NEC Kansai, Ltd.), 09 July, 1987 (09.07.87), Full text; Figs. 1 to 5 (Family: none)	4
A	JP 11-120890 A (Taiheiyo Seiko Kabushiki Kaisha), 30 April, 1999 (30.04.99), Full text; Figs. 1 to 7 (Family: none)	4

#### 国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl. 7 H01H37/76, 85/046, 85/08, 85/12

#### B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. ' H01H37/76, 85/00-85/62

#### 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報

1994-2004年

日本国実用新案登録公報

1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
Y A	JP 2001-325868 A (ソニーケミカル株式会社) 2001. 11. 22,全文,図1-9 & US 2001-4 4168 A	1-3		
Y A	JP 2000-306477 A (ソニーケミカル株式会社) 2000.11.02,全文,図1-7 & EP 104541 8 A & US 6452475 B ,	1-3 4		

## X C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X.」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 10.03.2004 国際調査報告の発送日 30.3.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 山本 忠博 単便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3372

国際出願番号 PCT/JP03/15603

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の	The state of the s	関連する  請求の範囲の番号
カテゴリー* Y A	JP 2000-285778 A (ソニーケミカル株式会社) 2000.10.13,全文、図1-13 & EP 10415 97 A & US 6344633 B	1-3
Y	JP 11-7876 A (内橋エステック株式会社) 1999.01.12,【請求項1】,図1 (ファミリーなし)	1-3
Y	JP 52-31363 A (マツクグロウーエジソン・コンパニー) 1977.03.09,全文,Fig1-46 & DE 2543889 A & FR 2287102 A & US 4041435 A	1, 3
Y .	JP 53-8755 A (マツクグロウ・エジソン・カンパニー) 1978.01.26,全文,第1-9図 & DE 2723487 A & FR 2352389 A & US 4101860 A	1, 3
A	日本国実用新案登録出願60-200537号(日本国実用新案登録出願公開62-107335号)の願書に添付した明細書および図面の内容を記録したマイクロフィルム(関西日本電気株式会社)1987.07.09,全文,第1-5図(ファミリーなし)	. 4
· A	JP 11-120890 A(太平洋精工株式会社) 1999.04.30,全文,図1-7(ファミリーなし)	4